

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**  
**PUBLIC RELATIONS DIVISION**  
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan

**PARA LANÇAMENTO IMEDIATO**

**N.º 3272**

*Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.*

*Questões de clientes*

Power Device Overseas Marketing Dept.A and Dept.B  
Mitsubishi Electric Corporation

[www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/](http://www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/)

*Questões da imprensa*

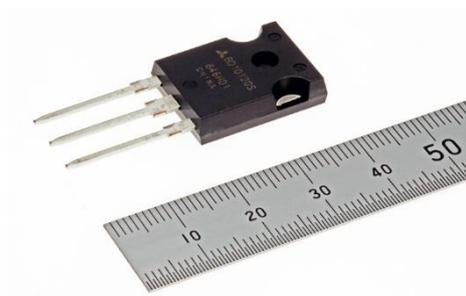
Public Relations Division  
Mitsubishi Electric Corporation  
[prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp](mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp)  
[www.MitsubishiElectric.com/news/](http://www.MitsubishiElectric.com/news/)

## **Mitsubishi Electric vai lançar um díodo de barreira Schottky SiC de 1200 V**

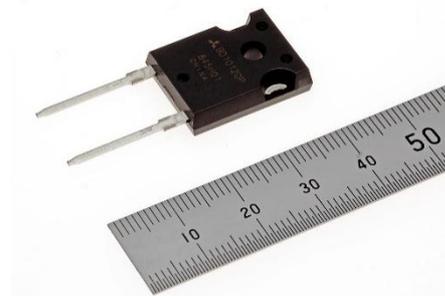
*Reduz a perda de energia e as dimensões físicas de sistemas de fornecimento de energia*

**TÓQUIO, 27 de março de 2019** – A [Mitsubishi Electric Corporation](http://www.MitsubishiElectric.com) (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento de um novo díodo de barreira Schottky de carboneto de silício de 1200 V (SiC-SBD) que reduz a perda de energia e as dimensões físicas de sistemas de fornecimento de energia para sistemas de energia fotovoltaica de infraestruturas e muito mais. O envio de amostras começa em junho de 2019 e as vendas começam em janeiro de 2020.

Os díodos vão estar em exposição nas principais feiras comerciais, incluindo a MOTORTECH JAPAN 2019 durante a TECHNO-FROTIER 2019 no complexo de exposições Makuhari Messe, em Chiba, no Japão, de 17 a 19 de abril, na PCIM Europe 2019 em Nuremberga, na Alemanha, de 7 a 9 de maio, e na PCIM Asia 2019, em Xangai, na China, de 26 a 28 de junho.



Estrutura SiC-SBD TO-247 de 1200 V



Estrutura SiC-SBD TO-247-2 de 1200 V

### **Funcionalidades do produto**

#### **1) O carboneto de silício ajuda a reduzir a perda de energia e as dimensões da estrutura**

- A conversão melhorada de energia traduz-se em 21% menos de perda de energia em comparação com produtos fabricados a partir de silício (Si)
- Permite a comutação a alta velocidade e a redução das dimensões de componentes periféricos, como reatores

#### **2) Maior fiabilidade graças à estrutura de barreira Schottky com junção (JBS)**

- Combinação de uma barreira Schottky com uma junção p-n
- A estrutura JBS permite atingir uma elevada fiabilidade

#### **3) Permite expandir a linha para várias aplicações**

- A estrutura TO-247-2, com uma distância de segurança de isolamento alargada, junta-se à estrutura TO-247 existente para abranger uma vasta gama de aplicações, incluindo bens de consumo.
- Em conformidade com a especificação AEC-Q101 do Automotive Electronics Council para utilização em automóveis (apenas BD20120SJ)

### **Calendário de vendas**

Série	Modelo	Estrutura	Especificações	Disponibilidade da amostra	Lançamento	
SiC-SBD de 1200 V	BD10120P	TO-247-2	1200 V/10 A	Junho de 2019	Janeiro de 2020	
	BD20120P		1200 V/20A			
	BD10120S	TO-247	1200 V/10 A			Abril de 2020
	BD20120S		1200 V/20A			
	BD20120SJ		1200 V/20 A AEC-Q101			

Desde a comercialização do seu primeiro módulo de potência com SiC-SBD e SiC-MOSFET em 2010 que a Mitsubishi Electric continua a contribuir para reduzir as dimensões e aumentar a eficiência energética de sistemas de inversores. Os consumidores estão a optar cada vez mais por produtos que incorporam SiC-SBD, incluindo sistemas de fornecimento de energia eficientes para sistemas de ar condicionado, equipamentos industriais, veículos ferroviários, entre outros. Em particular, a nova série SiC-SBD de 1200 V irá ajudar a satisfazer a crescente procura de semicondutores discretos utilizados na produção de energia fotovoltaica e no carregamento de veículos elétricos.

Nota: o desenvolvimento destes produtos SiC foi parcialmente apoiado pela New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) do Japão.

### Especificações principais

Modelo	BD10120S	BD10120P	BD20120S(J)	BD20120P
Especificações	1200 V/10 A		1200 V/20 A	
IFSM (máx. *)	95 A		155 A	
Tensão direta (típ.) Tj=25 °C	1,35 V			
Estrutura	TO-247	TO-247-2	TO-247	TO-247-2
Tamanho	15,9 × 41,0 × 5,0 mm			

\*8,3 ms, onda sinusoidal

### Linha da série SiC-SBD

(Novos produtos a negrito)

Série	Modelo	Especificações		Estrutura	Estado de distribuição
		Tensão [V]	Corrente [A]		
SiC-SBD	<b>BD10120S</b>	1200	10	TO-247	Amostras disponíveis a partir de junho de 2019
	<b>BD10120P</b>			TO-247-2	
	<b>BD20120S</b>		20	TO-247	
	<b>BD20120SJ</b>			TO-247	
	<b>BD20120P</b>	TO-247-2			
	BD20060S	600	20	TO-247	Amostras já disponíveis
	BD20060A			TO-263S	
	BD20060T			TO-220FP-2	MP

### Consciência ecológica

Estes produtos estão em conformidade com a diretiva 2011/65/UE e 2015/863/UE sobre Restrição de utilização de certas substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrônico (RoHS).

###

### Sobre a Mitsubishi Electric Corporation

Com quase 100 anos de experiência no fornecimento de produtos fiáveis e de alta qualidade, a Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) é um líder mundial reconhecido na produção, marketing e venda de equipamento elétrico e eletrônico utilizado em comunicações e processamento de informação, exploração espacial e comunicações por satélite, equipamento eletrônico, tecnologia industrial, equipamento de construção, energia e transporte. Integrando o espírito do seu lema empresarial, Changes for the Better, e do seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser uma empresa ecológica líder a nível mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou vendas de grupo consolidadas no valor de 4444,4 mil milhões de ienes (em conformidade com a IFRS; 41,9 mil milhões de dólares\*), no ano fiscal que terminou a 31 de março de 2018. Para mais informações: [www.MitsubishiElectric.com](http://www.MitsubishiElectric.com)

\*A uma taxa de câmbio de 106 ienes por dólar americano, determinada pelo mercado de câmbio de Tóquio a 31 de março de 2018